

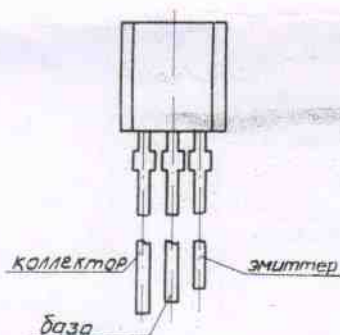


ТРАНЗИСТОРЫ КТ316АМ, КТ316БМ,
КТ316ВМ, КТ316ГМ, КТ316ДМ

ЭТИКЕТКА

Кремниевые планарно-эпитаксиальные $n-p-n$ -транзисторы КТ316АМ, КТ316БМ, КТ316ВМ, КТ316ГМ, КТ316ДМ в пластмассовом корпусе, предназначенные для работы в усилительных схемах устройств широкого применения.

Схема расположения выводов



Условная маркировка: КТ316АМ — 316А
КТ316БМ — 316Б
КТ316ВМ — 316В
КТ316ГМ — 316Г
КТ316ДМ — 316Д

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при $t = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения, тип транзистора	Норма	
	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($\mu = 0, I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}$)		
КТ316АМ	20	60
КТ316БМ, КТ316ВМ	40	120
КТ316ГМ	20	100
КТ316ДМ	60	300
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{\text{КБ}} = 10 \text{ В}$)	—	0,5
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{\text{ЭБ}} = 4 \text{ В}$)	—	1
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте		
($U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}, I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}, f = 10^6 \text{ Гц}$)		
КТ316АМ, КТ316ГМ	6	—
КТ316БМ, КТ316ВМ, КТ316ДМ	8	—
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер, В ($I_{\text{К}} = 10 \text{ мА}, I_{\text{Б}} = 1 \text{ мА}$)	—	0,4
Напряжение насыщения база—эмиттер, В ($I_{\text{К}} = 10 \text{ мА}, I_{\text{Б}} = 1 \text{ мА}$)	—	1,1
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, нс ($U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}, I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}, f = 10^6 \text{ Гц}$)	—	150
Время рассасывания, нс ($I_{\text{К}} = 10 \text{ мА}, I_{\text{Б}} = 1 \text{ мА}, I_{\text{Б2}} = 1,2 \text{ мА}, R_{\text{К}} = 75 \text{ Ом}$)	—	15
КТ316АМ, КТ316БМ	—	10
КТ316ВМ	—	15
Граничное напряжение, В ($I_{\text{Э}} = 1 \text{ мА}$)	5	—
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}, f = 10^6 \text{ Гц}$)	—	3
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{\text{ЭБ}} = 0, f = 10^6 \text{ Гц}$)	—	2,5

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ

золото — 1,2496 г

0,0616

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ316АМ, КТ316БМ, КТ316ВМ, КТ316ГМ, КТ316ДМ соответствуют техническим условиям 0.336.030 ТУ.

Место для простановки
конкретного типа транзисторов,
находящихся в данной упаковке

КТ-316БМ

Место для штампа ОТК,
год и месяц изготовления

ОТК
07-84

